









	<h2 style="color: #D9534F;">SI6973DQ-T1-E3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI6973DQ-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 20V 4.1A 8TSSOP
	Datenblätter:  SI6973DQ-T1-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 9535 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI6973DQ-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 4.1A 8TSSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	9535 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 250µA (Min)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 4.8A, 4.5V
Leistung - max	830mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 4.5V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 4.1A 830mW
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.1A

SI6973DQ-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6973DQ-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6973DQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI6973DQ-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI6973DQ VISHAY SI6973DQ VISHAY</p>	 <p>SI6973DQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 4.1A 8TSSOP</p>	 <p>SI6969DQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 8TSSOP</p>	 <p>SI6973DQ-T1 SILICON SI6973DQ-T1 SILICON</p>
 <p>SI6975DQ VISHAY SI6975DQ VISHAY</p>	 <p>SI6973DQ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 4.1A 8TSSOP</p>	 <p>SI6975DQ-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 4.3A 8TSSOP</p>	 <p>SI6969DQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 8TSSOP</p>

SI6973DQ-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI6973DQ-T1-E3	Electro-Films (EFI) / Vishay SI6973DQ-T1-E3 Datenblatt	SI6973DQ-T1-E3-Datenblätter	SI6973DQ-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI6973DQ-T1-E3
Vishay				
SI6973DQ-T1-E3 Electronic	SI6973DQ-T1-E3-Komponenten	SI6973DQ-T1-E3-Verteiler	SI6973DQ-T1-E3-Bild	SI6973DQ-T1-E3-Teil
SI6973DQ-T1-E3 Preis	SI6973DQ-T1-E3 Hersteller	SI6973DQ-T1-E3 Bild	SI6973DQ-T1-E3 Aktie	SI6973DQ-T1-E3 Inventar
SI6973DQ-T1-E3 Neu	SI6973DQ-T1-E3 Original	SI6973DQ-T1-E3 garantiert	SI6973DQ-T1-E3 RFQ	SI6973DQ-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited